Nd: YAP 激光晶体偏振光谱的测量与分析

颖1.蔡志平2* 陈

(1. 厦门大学物理学系, 2. 厦门大学电子工程系, 福建 厦门 361005)

摘要: 从分析 Nd: YAP 和 Nd: YAG 两种激光晶体的优缺点入手,指出前者的各向异性能够提供许多特殊的用途,讨论了 它的能级和光谱特性,详细介绍了该晶体偏振吸收谱、偏振受激发射截面谱和荧光寿命的测量方法,并给出了两块沿 a 轴 切割的 Nd: YAP 晶体的测量结果和分析,这些分析与测量反映了 Nd: YAP 晶体各向异性的特性优势,将使其在固体激光 器应用领域可以成为传统 Nd: YAG 晶体很有潜力的替代者.

关键词: Nd: YAP; 荧光寿命; 受激发射截面; 吸收系数 中图分类号: TN 248 文献标识码: A

掺钕铝酸钇晶体(Nd: YAlO3 或 Nd: YAP)和掺 钕钇铝石榴石晶体(Nd:Y3AbO12或Nd:YAG)都是用 Y₂O₃-Al₂O₃体系生长出来的,并都可掺入三价稀土钕 离子,前者分子比为1:1,呈现钙钛矿相:后者分子比为 3:5, 呈现石榴石相. 三价钕离子进入 YAP 晶格中, 占 据了三价钇离子的位置,这种掺杂可以避免电荷补偿 效应,使掺杂不会对晶格场的对称性造成太大损害^[1]. Nd^{3+} 的电子壳层结构是 $4f^{3}5s^{2}5p^{6}$, 未满层为 4f 子 层,电子跃迁就发生在这个子层的各个不同的能级间. 因为 4f 子层不是原子的最外层,所以它的能级受到晶 格场的影响比较小,因此Nd:YAP的光谱形状和 Nd: YAG 的非常类似. 但 YAP 属正交晶系, 是各向异性 的, 而 YAG 属于立方晶系, 是各向同性的. 各向异性 以及由此产生的自然双折射对激光器应用来说更有 利.因为沿着不同晶轴来切割,可以获得不同的增益系 数、偏振方向和受激发射截面[1].这个特性可以用来定 制 Nd: YAP 晶体以适应具体的应用. 同时, 像 YAP 这 样具有天然双折射特性的基质材料,对于克服热致退 偏振和热透镜效应十分有利^[1].人们对 YAP 光学性能 的了解不如 YAG 深入, 尤其是它各向异性方面的性 能和参数有待更详细的测量和分析,这对于进一步推 广YAP 晶体的应用是必要的. 本文将研究 YAP 的偏 振光谱特性,同时给出相应的测量与分析.

文章编号: 0438 0479(2005) Sup 0338 05

Nd³⁺ 的能级和 YAP 晶体的光轴 1

1.1 Nd³⁺的能级

Nd³⁺ 4f 子层的 3 个电子能够处于不同的量子态 中,可以形成一系列的原子能级,如图1所示,基态是 ⁴*I*_{9/2},平衡态时原子基本上都集中在该能级上,通过光 泵浦、处于基态上的 Nd³⁺ 离子可以被抽运到⁴ F^{3/2}以上 的各个激发态中.其中只有 ${}^{4}F_{13/2}$ 能级可以提供 N d³⁺ 一个相对较长的寿命,大约为 180 μ_{s} , $\pi^{4}F_{3/2}$ 为一个亚 稳态. 被激发上去的电子通过无辐射驰豫跃迁到这个 能级,然后再跃迁到不同的终态,⁴I15/2、⁴I13/2、⁴I11/2和 ${}^{4}I_{9/2}$,形成发射谱中不同的发射波段,谱线中心分别在 1.340 µm、1.079 µm 和 0.930 3 µm.称它们为发射波 段是因为 Nd: YAP 晶体中的钕离子处于基质材料的 晶格势场中,根据斯塔克效应,孤立原子能级分裂成为 若干个能级,从而形成了若干条具有一定间隔的多重 谱线.



收稿日期: 2005-03-05

基金项目:国家自然科学基金(602770026,90206039)资助 作者简介: 陈颖(1980-), 女, 硕士研究生.

Fig. 1 Energy level of Nd: YAP

通讯作者: zp cai@ jingxian.xmu.edu.cn 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 1 Nd: YAP 晶体的能级

1.2 YAP 晶体的光轴

YAP是一种负双轴的正交晶系晶体,属于 D_{2h}^{16} 空间群.两个光轴位于acc平面上,互成70°角,c轴是它们的角平分线⁽²⁾,如图2所示.因此,当电场 $E \parallel b$ 时,偏振的吸收和增益系数都比 $E \parallel a$ 和 $E \parallel c$ 偏振的大. 但是后两者在一个发射带中拥有若干条增益相当的谱线,可以满足人们的不同要求.



Fig. 2 Optical axes of YAP crystal

2 光谱分析

2.1 吸收谱

对于 Nd: YAG 晶体来说, 主要的吸收线出现在 808 nm 附近, 线宽大约为 0.9 nm. 而对于 Nd: YAP 晶 体来说, 不同的偏振方向在 800 nm 附近存在着不同的 峰值中心. 如果考虑非偏振泵浦光束的话, 总共可以获 得 4~ 5 nm 的吸收带宽, 这个宽度要比 Nd: YAG 大很 多. 所以该晶体对于泵浦源热稳定性的要求就没有那 么苛刻^[2]. 如果我们用 AlGaAs 激光二极管阵列来泵 浦, 780~ 830 nm 就是主要吸收带, 本文将在实验部分 给出相应的吸收系数.

2.2 荧光光谱

2.2.1⁴*F*_{3/2}→⁴*I*_{9/2}跃迁

因为这个跃迁的终态是⁴ $I_{9/2}$ 多重态中一个比较高 的斯塔克能级,该能级很接近基态,难以形成粒子数反 转,所以这个跃迁的激光通常在较低的温度下获得.此 时,在它的多重分支中, $R_1 = Z_5$ 分支以 ${}^4I_{9/2}$ 多重态的 最高能级为终态,该能级上面的集居数最少,因而拥有 最低阈值,较易出光,跃迁波长大约为 0. 930 3 µm,荧 光强度也不小,特别是 c 偏振出射.荧光线宽大约是 Nd: YAG 的 3 倍,故发射截面峰值比后者小.已往人 们的注意力主要集中在 Nd: YAP 晶体的 ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{11/2}$ 和 ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{13/2}$ 跃迁波段,由于这两个波段拥有较大受 激发射截面并且易于出光. 然而,随着蓝色激光器越来 越受到关注,对该晶体在 ${}^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{9/2}$ 跃迁波段的研究 是很有必要的. Zarrabi J H 等人已利用腔内倍频技术 研制成了一种输出波长为 465 nm 的小型蓝色激光

2.2.2 ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow I_{11/2}$ 跃迁

这分支是3个主要的荧光波段中最强的一支,因 为它终态在平衡态下几乎是空的,极易形成粒子数反 转,处于 YAP 晶体中的钕离子在这个跃迁的带宽比 YAG 中大, 而且它的荧光不是集中于一支, 而是分布 在 3 支主要的谱线上, 波长分别为 1.064 5 µm、 1.072 5 µm 和 1.079 5 µm, 所以受激发射截面就比较 小. 同时 YAP 晶体中的 钕离子具 有比较大的平均辐射 跃迁几率, 故荧光寿命较短. 这两个原因促使Nd: YAG 在1.064 µm 处性能优于 Nd: YAP 在1.079 µm 处的 性能,此外,YAG 基质的热学特性比较好,对称性也比 较简单.尽管如此,研究者们对于Nd:YAP在这个波段 的跃迁行为仍然是表现出了极大的兴趣. 原因是发展 紫外波段 260 nm 到 280 nm 的激光光源被认为是通 过大气层进行短距离通讯的一种很有前景的方法.这 种通讯系统广泛地应用于军事和民用方面. 由于该波 段处于日光的盲区,背景噪声比较小,故只需要中等的 激光光强就可以满足要求. 而且要使光源波长具备不 连续的可调节性,则可以提高系统的适应性以允许多 信道和双工通讯.因 Nd: YAP 是一种双光轴的晶体, 它的发射谱在这个跃迁波段是由 1 050 nm 到1 105 nm 的几个尖锐的谱线组成,宽度为 50 nm.其中,最强 的一支, 位于 1 079.5 nm, 为 b 偏振, 它的有效受激发 射截面可以和 Nd: YAG 相比拟. 对于 a 偏振或 c 偏振 的发射谱来说,并非只有单独的一条谱线而是由一系 列间隔足够大并且强度相当的谱线所组成. 这样, 这两 个偏振方向尤其是 c 偏振. 就成为研究1 064~ 1 099 nm 发光并通过倍频和四倍频技术使之过渡到 266~ 275 nm 紫外波段的一个十分不错的选择^[4].

2.2.3 ⁴*F*_{3/2} →⁴*I*_{9/2}跃迁 对于1.3 μm 的跃迁波目

对于 1.3 µm 的跃迁波段来说,虽然 Nd: YAG 在 1.32 µm 仍然拥有比 Nd: YAP 在 1.34 µm 低的阈值, 然而由于后者的受激发射截面较大,故拥有斜率较大 的特征曲线以及最大的输出功率,因此它的性能较前 者是更好的.同时, Nd: YAP 还具备其他两个优势:第 一,如前所述,由于基质的各向异性结构,它输出的是 天然的偏振光,这是一个非常重要的优势,因为像 Nd: YAP 这样本身具有双折射特性的晶体,光束质量不易 遭受到热致退偏振的破坏;第二, Nd: YAP 在这个跃 迁波段的分支比也较其它掺钕的晶体材料大^[2].这样, 随着在这个波段出现了一些新的应用,该晶体这个跃 迁的性能就引起了人们的极大兴趣.比如说在医疗方 面,它是一把准确的外科手术刀,在光纤通信方面,这 个波长位于一个主要的传输窗口,可以同时实现低损

器^[3] ◎ 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House: All rights reserved. http://www.cnki.net (2)

3 测量原理

3.1 吸收系数

将光强为 *I*₀ 的光入射到长度为 *l* 的晶体棒时, 透 射光强为 *I*, 则晶体棒吸收系数 α可从下式求得:

$$\alpha = -\frac{\ln(\frac{I}{I_0})}{l} \tag{1}$$

晶体吸收系数和光入射前位于基态的离子密度 *N* 成正比,比例系数为吸收截面 σ_α,如公式(2):

 $\alpha = \sigma_a N$

由此可以推出受激吸收截面 Ф. 在常温下光入射 前位于基态的离子密度 N 其实就是掺杂的浓度.

3.2 荧光寿命

使用荧光衰减的方法测量⁴F_{3/2}能级的荧光寿命. 用信号发生器生成振幅为 2.5 V、频率为 2 kHz 的方 波去调制 808 nm 的半导体激光器,所产生的脉冲激光 作为光源,入射到样品.利用了光谱仪中的稳定度测量 功能,对探测到的荧光光强进行扫描跟踪,计算机自动 记录,绘出时间 稳定度曲线,如图 3 所示.



图 3 Nd: YAP 的荧光衰减实验曲线

Fig. 3 Fluorescence attenuation experiment curve of Nd: YAP

根据公式

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{t_f}} \tag{3}$$

将开始产生荧光的时刻设为 t=0, 相应的荧光光 强为 I_0 , 取荧光光强衰减为 I_0/e 的时间为荧光寿命 T_f . 图 3 中 $t_0 = 202 \mu_s$ 是脉冲泵浦结束时刻, 即荧光开 始时刻; 光强下降为 I_0 的时间为 $t_{e=}$ 377 μ_s , 观测到的 荧光寿命 $T_f = t_0 - t_e$ 即 175 μ_s .

3.3 受激发射截面

受激发射截面可以通过很多方法测出,本文选用

电子从 *j i* 能级跃迁时发出的波长为 λ, 光强为 *I_{ji}(λ*), 其受激发射截面 σ_i(λ)由下式给出^[5]:

$$\sigma_{ji}(\lambda) = \frac{\eta \chi^{5} \beta_{ji} I(\lambda)}{\tau_{f} \int N(\lambda) d\lambda F_{j} 8\pi n^{2} c}$$

$$\tag{4}$$

其中, n是上能级的辐射量子效率, T_i 是荧光寿命, β_i 是*i j* 跃迁的荧光分支比, *F_j* 是被抽运上去的粒子数 在*j* 能级的比例系数, 由玻尔兹曼分布决定. 总的光强 $I(\lambda) = \sum_{ii} I_{ji}(\lambda)$. 通常, 我们假设无辐射驰豫可以忽略 不计, 即 n= 1, T_j = T_k, T_k 是辐射寿命. $\int M(\lambda) d\lambda$ 是荧 光光谱的面积. *c* 为真空中的光速, *n* 为晶体的折射率. 如果入射光从不同光轴入射, 考虑到晶体的各向异性, 折射率 *n* 就和光轴的取向有关. 如果考虑材料的色散 和 3 个晶轴的各向异性, 根据 Sellmeier 公式^[6], 折射 率 *n* 必须改写成:

$$n_{P}^{2}(\lambda) = 1 + \frac{B_{P}}{1 - \frac{C_{P}}{\lambda^{2}}} + \frac{D_{P}}{1 + \frac{E_{P}}{\lambda^{2}}}$$
(5)

其中 p = a, b, c 为3 个光轴. 式中常数 B_p, C_p, D_p 和 E_p 在 293 K 温度下的值由表 1 给出.

表1 折射率参数和光轴的关系

T ab. 1	Relationship	betw een	refractive	index	and the
	onticalares				

opriariara				
光轴	B_p	$C_p / 10^{-2} \mu \mathrm{m}^2$	$D_p / 10^{-2}$	$E_p/\mu_{ m m^2}$
a	2.715339	1. 237917	9.034607	8. 389919
b	2.682368	1. 219273	8.804046	8. 133462
с	2.643755	1. 081 18 1	- 11.60196	3. 932196

由计算可得出 3 个主要跃迁波段中 *b* 偏振和 *c* 偏 振光的折射率平均值, 连同荧光分支比, 列在表 2 中. 这样, 公式(4)最后表达为

$$\sigma_{pi}(\lambda) = \frac{\chi \beta P_{d}(\lambda)}{8\pi n_{p}^{2} c \tau_{f} \int \lambda P_{d}(\lambda) d\lambda}$$
(6)

其中, p = a, b, c; i = 1, 2, 3. 式中的下标 $p \setminus i$ 分别代表 偏振方向和不同的跃迁, P_a 代表探测到的荧光功率. 实验样品的掺杂浓度只有 1%, 所以浓度猝灭可忽略 不计. 同时, 被抽运到激发态的电子很快就通过无辐射 驰豫跃迁到亚稳态⁴ $F_{3/2}$, 因此假设 $n n F_i$ 为 1 是合理 的. ${}^{4}F_{3/2}$ 能级的荧光寿命可通过荧光衰减实验测量得 到. 显然, 只要测量了 YAP 晶体不同光轴的荧光光谱, 按公式(6) 就可以计算得 YAP 沿不同光轴的受激发射 截面 $q_{ii}(\lambda)$.

由 Brian F. Aull 所改进的 βτ 的方法^[5] Brian F. Aull China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 3 个跃迁波段的折射率 nu、ne 和荧光分支比

Tab.2 Refractive index and fluorescent branching ratio for the three emission band

ባር ነር ነው FЛ	χμ _m	折射率		荧光
跃江波段		n_b	n_c	分支比
${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{9/2}$	0. 867~	1.93169	1.91305	0. 24
- 3/2 - 9/2	0. 931	11,70,107		
${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{11/2}$	1. 051~	1.92919	1.9084	0. 63
- 5/2 - 11/2	1. 106			
${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{13/2}$	1. 318~	1 9278	1 9029	0.13
- 5/2 - 15/2	1. 434	1. 7270	1.9029	0. 15

4 实验方法、结果和分析

样品是两块沿 a 轴切割的 Nd: YAP 晶体.其中, 一块是 $\phi_{3 mm} \times 3 mm$ 的圆柱体,用于吸收谱的测量; 另一块是 $4 mm \times 4 mm \times 5 mm$ 的长方体,用于测量发 射谱和荧光寿命,掺杂浓度都为 1%.

4.1 吸收谱

YAP不同偏振方向吸收谱差别很大.本实验的样 品是沿 a 方向切割的,所以必须分别测量 b 方向和 c 方向的偏振吸收谱.用两种不同的装置配置分别进行 了测量.光源是溴弧灯.它可以提供比较宽的入射光 谱. 晶体样品放在一个黄铜套里面以实现良好的散热. 透射光经由一个凸透镜聚焦,通过单色仪分光,再由光 电倍增管将光信号转变为电信号,最后把数据输送到 计算机中进行自动处理.这两个方向测量惟一差别在 于偏振片的位置.配置一,偏振片被放在晶体样品的前 方以实现偏振入射;配置二,偏振片被放在样品后面, 这样入射光就是非偏振态的. 据文献[3] 的叙述, 从前 者获得的吸收系数应是从后者获得的吸收系数的2 倍.原因是根据公式(2),后者的非偏振入射会导致真 正对 b 或 c 偏振方向的吸收系数有贡献的有效基态粒 子数的下降,尽管这个2倍的关系只是一个粗略的估 计. b 和 c 两个方向的偏振吸收谱的测量结果如图 4 所 示.

为了保证所探测到的透射光偏振方向的准确性, 选择 802 nm 为参考波长.因为在这个点 Nd: YAP 晶 体对 b 偏振分量的吸收最强而对 c 偏振分量几乎没有 表现出什么吸收,这样就可以运用出射光强稳定度的 测量定出偏振片的准确透光位置.实验测出的两个偏 振方向的吸收峰所在位置和文献中给出的非常吻合. 从图 4 可看出, c、b 两个偏振分量的吸收峰值分别出现 在 802.7 nm 和 797.2 nm 处.它们各自有 1.4 nm 和 3.0 nm 的线宽,如果考虑非偏振泵浦入射, Nd; YAP



晶体材料可在 800 nm 附近提供 4~ 5 nm 的吸收带 宽,这个宽度大约是 Nd: YAG 晶体所能提供的吸收带 宽的 5 倍.这对 Nd: YAP 是一个非常重要的优势.因 为这样,激光器对泵浦光源的热稳定性的要求就可降 低,对于通常使用的半导体激光器泵浦源来说,维持它 的热稳定性一直是一个棘手的问题,因为半导体材料 的禁带宽度会随着温度的升高而变窄,这将造成输出 波长的红移.同时,为了获得最佳效率的吸收,入射泵 浦光的偏振方向必须是 b 方向的.因为对于 a 切割的 晶体棒来说,这个方向的吸收系数大约是 c 方向的1.2 倍.

4.2 发射谱

实验样品由输出波长为 808 nm 的半导体激光器 来进行端泵浦.为了防止没有被充分吸收的泵浦光混 杂到被探测到的荧光中,我们在样品后方放置了一个 对泵浦波长具有强烈吸收的滤光片.和吸收谱一样,对 于沿 *a* 方向切割的长方体晶体,必须分别测量 *b* 偏振 和 *c* 偏振的发射谱.所测得的⁴ F_{3/2} \rightarrow ⁴ I_{9/2}、⁴ F_{3/2} \rightarrow ⁴ I_{1/2} 和⁴ F_{3/2} \rightarrow ⁴ I_{13/2} 3种跃迁时 *b* 偏振和 *c* 偏振的发射谱, 分别如图 5、6 和 7 所示.

由图可以看出,除了 ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}I_{13/2}$ 跃迁之外,对其



© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图 6 ⁴ F_{3/2} →⁴ I_{11/2} 跃迁时 b、c 方向发射截面谱





余两个跃迁, b 偏振方向的受激发射截面都比 c 偏振 方向大很多, 所以采用b偏振出光可以有效降低泵浦 的阈值, 提高输出效率. 将测量结果和文献中给出的 Nd: YAG晶体的相应值做比较可知, 对⁴ $F_{3/2}$ →⁴ $I_{11/2}$ 来 说, 前者的峰值截面和后者差不多; 而对于⁴ $F_{3/2}$ → ⁴ $I_{13/2}$ 跃迁来说, 前者的峰值截面大概是后者的 2~3 倍,因此 Nd: YAP 的发光性能比 Nd: YAG 更胜一筹.

5 结 论

本论文详细讨论了 Nd: YAP 晶体的光谱特性,将 它和固体激光器中最常用的 Nd: YAG 晶体光谱进行 了对比,指出前者的优势在于该材料各向异性的特性. 这种特性有两方面好处,其一,选择不同的晶轴和偏振 方向,可以获得迥异的光谱特性,从而可以为满足不同 的需要提供便利;其二,固有的双折射性质可以有效地 降低热致退偏振和热透镜效应对光束质量造成的危 害,这点对于固体激光器来说是非常有利的.

参考文献:

- Weber M J, Varitimos T E. Optical spectra and intensities of Nd³⁺ in YAlO₃ [J]. J. Appl. Physics, 1971, 42 (12): 4996-5005.
- [2] Boucher M, Musset O, Boquillon J P, et al. Multiwatt CW diode end pumped Nd: YAP laser at 1.08 and 1.34 µm: influence of Nd doping level[J]. Opt. Comm., 2002, 212: 139-148.
- [3] Zarrabi Joseph H, Gavrilovic Paul, Singh Shobha. Intracavity, frequency doubled, miniaturized Nd: YAIO₃ blue laser at 465 nm[J]. App. Phys. Let., 1995, 67(17): 2 439 - 2 441.
- [4] Hanson F, Poirier P. Multiple wavelength operation of a diode pumped Nd: YAlO₃ laser[J]. J. Opt. Soc. Am. B, 1995, 12(7): 1 311-1 315.
- [5] Aull Brian F, Jenssen Hans P. Vibronic interactions in Nd:YAG resulting in nonreciprocity of absorption and stimulated emission cross sections[J]. IEEE. J. Quantum Electronics, 1982, QE 18(5):925-930.
- [6] Zeng Z D, Shen H Y, Huang M L, et al. Measurement of the refractive index and thermal refractive index coefficient of Nd: YAP crystal[J]. Applied Optics, 1990, 29(9): 1 281-1 287.

Measurement and Analysis for Polarized Spectrum of Nd: YAP Crystal

CHEN Ying¹, CAI Zhr ping²

(1. Dept. of Phys., Xiamen Univ., 2. Dept. of Electronic Engineering, Xiamen Univ., Xiamen 361005, China)

Abstract: This paper starts with analyzing advantages and disadvantages of Nd: YAP and Nd: YAG. It indicates that the anisor tropic feature of the former can provide some special utilities. The energy levels and spectral properties for Nd: YAP are delivered. Techniques for measuring the polarized absorption spectrum, polarized stimulated emission cross section and fluorescent lifetime of Nd: YAP crystal are fully discussed. The measured results and analyses of two Nd: YAP samples which are cut along a crystallor graphic axis are also presented. These analyses and measurement comprehensively indicate that the superiority of Nd: YAP coming from its anisotropic feature will make it become a very promising substitute for the traditional Nd: YAG crystal in the practical field of solid state lasers.

Key words: Nd: Y.A.P; fluorescence lifetime; stimulated emission cross section; absorption coefficient (2011) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net